TAIWAN SEMICONDUCTOR

RoHS COMPLIANCE

TSC2411

General Purpose NPN Transistor

SOT-23

Pin Definition:
1. Base
2. Emitter
3. Collector

PRODUCT SUMMARY

BV_{CEO}	40V
BV_{CBO}	75V
I_C	600mA
$V_{CE(SAT)}$	0.5V @ I_C / I_B = 380mA / 10mA

Features

- Driver Stage of AF Amplifier
- General Purpose Switching Application

Structure

- Epitaxial Planar Type
- Complementary to TSA1036CX

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSC2411CX RFG	SOT-23	3Kpcs / 7" Reel

Note: "G" denotes for Halogen Free

Absolute Maximum Rating (Ta = 25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	75	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Collector Current	I_C	600	mA
Collector Power Dissipation	P_D	225	mW
Operating Junction Temperature	T_J	+150	°C
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_{STG}	- 55 to +150	°C

Note: 1. Single pulse, Pw=20ms, Duty≤50%
2. When mounted on a 40 x 50 x 0.7mm ceramic board.

Electrical Specifications (Ta = 25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector-Base Breakdown Voltage	I_C = 10uA, I_E = 0	BV_{CBO}	75	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage	I_C = 10mA, I_B = 0	BV_{CEO}	40	--	--	V
Emitter-Base Breakdown Voltage	I_E = 10uA, I_C = 0	BV_{EBO}	6	--	--	V
Collector Cutoff Current	V_{CB} = 60V, I_E = 0	I_{CBO}	--	--	0.1	uA
Emitter Cutoff Current	V_{EB} = 3V, I_C = 0	I_{EBO}	--	--	0.1	uA
Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C / I_B = 380mA / 10mA	$V_{CE(SAT)}$ 1	--	0.2	0.5	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C / I_B = 150mA / 15mA	$V_{CE(SAT)}$ 2	--	0.2	0.4	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C / I_B = 500mA / 50mA	$V_{CE(SAT)}$ 3	--	0.45	0.75	V
Base-Emitter Saturation Voltage	I_C / I_B = 150mA / 15mA	$V_{BE(SAT)}$ 1	0.75	--	0.95	V
Base-Emitter Saturation Voltage	I_C / I_B = 500mA / 50mA	$V_{BE(SAT)}$ 2	--	--	1.2	V
DC Current Transfer Ratio	V_{CE} = 1V, I_C = 150mA	h_{FE}	82	--	390	
Transition Frequency	V_{CE} =5V, I_C=-20mA, f=100MHz	f_T	300	--	--	MHz
Output Capacitance	V_{CB} = 5V, f=1MHz	Cob	--	6	--	pF

Electrical Characteristics Curve (Ta = 25°C, unless otherwise noted)

Figure 1. DC Current Gain

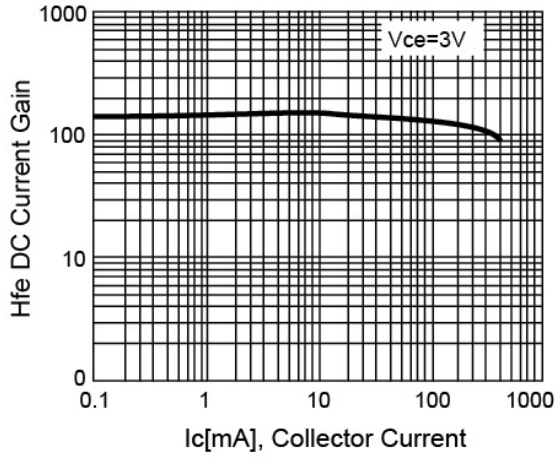


Figure 2. $V_{CE(SAT)}$ vs. Ic

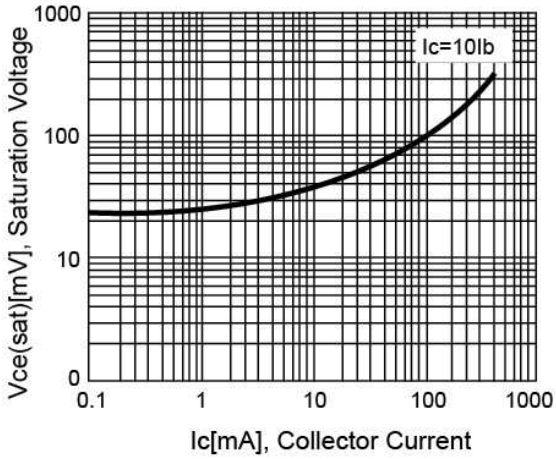


Figure 3. $V_{BE(SAT)}$ vs. Ic

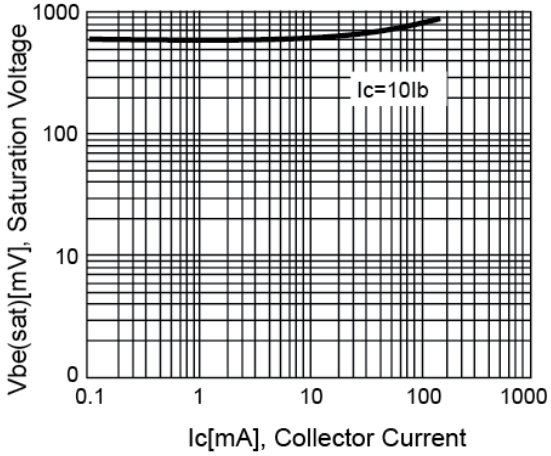


Figure 4. Cutoff Frequency vs. Ic

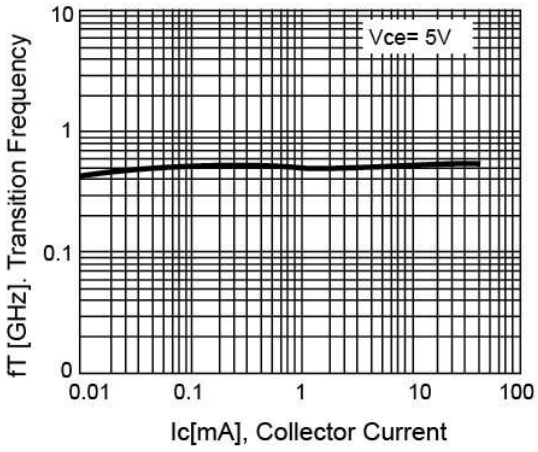
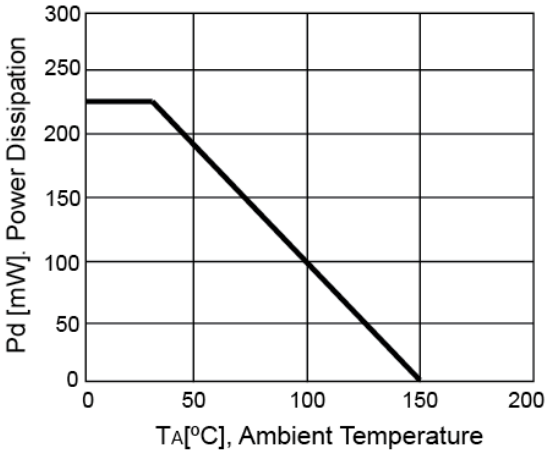


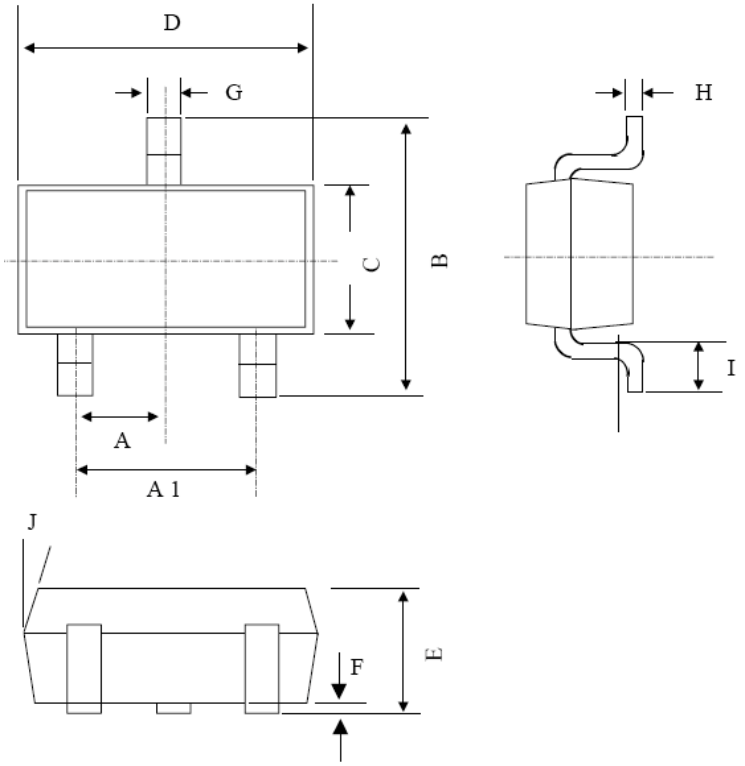
Figure 5. Power Derating Curve



TSC2411

General Purpose NPN Transistor

SOT-23 Mechanical Drawing



SOT-23 DIMENSION				
DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX.
A	0.95 BSC		0.037 BSC	
A1	1.9 BSC		0.074 BSC	
B	2.60	3.00	0.102	0.118
C	1.40	1.70	0.055	0.067
D	2.80	3.10	0.110	0.122
E	1.00	1.30	0.039	0.051
F	0.00	0.10	0.000	0.004
G	0.35	0.50	0.014	0.020
H	0.10	0.20	0.004	0.008
I	0.30	0.60	0.012	0.024
J	5º	10º	5º	10º

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9